ZEMRIS 12.02.2014.

1. ISPITNI ROK IZ ELEKTRONIKE 1

ZADATAK 1. Koncentracije manjinskih nosilaca na p i n strani silicijske pn diode su $n_{0p} = 3 \cdot 10^1$ cm⁻³ i $p_{n0} = 4 \cdot 10^{14}$ cm⁻³. Vrijedi $L_p = 15$ µm $<< w_n$ i $L_n >> w_p = 1,5$ µm. Pokretljivosti nosilaca su $\mu_n = 550$ cm²/Vs i $\mu_p = 300$ cm²/Vs, a naboj nakrcanih manjinskih elektrona je $Q_n = 2,4 \cdot 10^{-14}$ C. Površina diode je S = 1 mm², a temperatura je T = 300 K. Pretpostaviti m = 1.

- a) Odrediti iznos propusnog napona U_D priključenog na diodu. (2 boda)
- b) Izračunati struju zasićenja i odrediti struju kroz diodu za napon U_D iz točke a). (3 boda)
- c) Nacrtati raspodjelu manjinskih nosilaca za napon U_D iz točke a) (označiti sve karakteristične vrijednosti). (2 boda)
- d) Ako serijski otpor diode iznosi 10 Ω, koliki napon je potrebno priključiti na diodu da bi potekla struja: $i_D = 1 \text{ [mA]} + 0.3\sin(\omega t) \text{ [mA]}$? (3 boda)

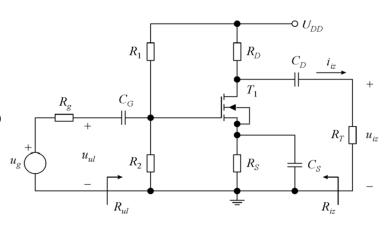
ZADATAK 2. Dinamički parametri n-kanalnog MOSFET-a s faktorom modulacije kanala $\lambda=0$, u radnoj točki uz $U_{DS}=1$ V, su $r_d=1$ k Ω i $g_m=2$ mA/V. Ako se U_{DS} poveća 4 puta uz nepromijenjen U_{GS} , izračunati:

- a) struju odvoda I_D , (**7 bodova**)
- b) dinamičke parametre g_m , r_d i μ u novoj radnoj točki. (3 boda)

ZADATAK 3. Za pojačalo na slici zadani su sljedeći podaci: $U_{DD} = 12$ V, $R_g = 500$ Ω, $R_1 = 300$ kΩ, $R_2 = 180$ kΩ, $R_D = 2$ kΩ, i $R_T = 3.3$ kΩ. Parametri n-kanalnog MOSFET-a su K = 2.25 mA/V² i $U_{GSO} = 0.5$ V. Generator signala daje sinusni signal amplitude 400 mV, dok amplituda izmjenične struje kroz trošilo R_T iznosi 600 μA.

Pretpostaviti da se radna točka tranzistora nalazi u zasićenju, te zanemariti porast struje odvoda s izlaznim naponom.

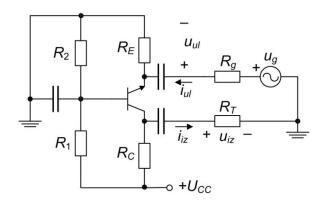
- a) Nacrtati nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku analizu, odrediti dinamičke parametre tranzistora, te izvesti izraz i izračunati iznos pojačanja $A_{Vg} = u_{iz}/u_g$. (4 boda)
- b) Odrediti statičku radnu točku, tj. izračunati U_{GSQ} , I_{DQ} , i U_{DSQ} . (4 boda)
- c) Skicirati statički radni pravac u
 polju izlaznih karakteristika
 tranzistora. Označiti statičku radnu
 točku, te presjecišta statičkog radnog
 pravca s koordinatnim osima.
 (2 boda)



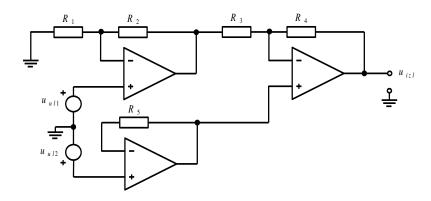
ZEMRIS 12.02.2014.

ZADATAK 4. Za pojačalo na slici zadani su sljedeći podaci: $U_{CC} = 15$ V, $R_g = 500$ Ω, $R_1 = 56$ kΩ, $R_2 = 18$ kΩ, $R_C = 3.9$ kΩ, $R_E = 1.8$ Ω i $R_T = 2.7$ kΩ. Zadano je da vrijedi $\beta \approx h_{fe} = 100$, $U_\gamma = 0.7$ V. Zanemariti porast struje kolektora u normalnom aktivnom području. $U_T = 25$ mV.

- a) Odrediti statičku radnu točku tranzistora, tj. izračunati I_{BQ} , I_{CQ} , U_{CEQ} . (3 boda)
- b) Nacrtati nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku analizu te izvesti izraz za naponsko pojačanje $A_V = u_{iz}/u_{ul}$, strujno pojačanje $A_I = i_{iz}/i_{ul}$, ulazni otpor $R_{ul} = u_{ul}/i_{ul}$, te pojačanje $A_{Vg} = u_{iz}/u_g$. (7 bodova)



ZADATAK 5. U sklopu na slici operacijska pojačala su idealna. Izvesti izraz za pojačanje $u_{izl} = f(u_{ul1}, u_{ul2})$ za pojačalo na slici (8 bodova).



Izabrati vrijednosti otpornika da se dobije izlazni signal u_{izl} za zadani ulazni signal $u_{ul1} - u_{ul2}$ (2 boda).

